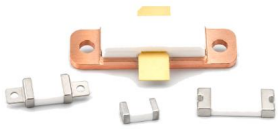
产品分类目录

射频电阻器

射频电阻器在高频电路中提供受控电阻，用于端接、固定衰减、偏置网络、反馈路径和射频负载。实际应用中需要关注阻值精度、功率耗散、频率响应、回波损耗和封装寄生参数。



产品: 4

版本: 2 · 修订日期: 2026-11-11



LCRES-R15OHM

15 Ω GaAs薄膜电阻裸芯片

电阻值: 15 Ω (典型值); 线性工作电流: 0.35 A (典型值); 最大承受电流: 0.8 A (最大值). 裸片平面尺寸: 0.5 × 0.5 mm.

电阻数量: 数值: 1

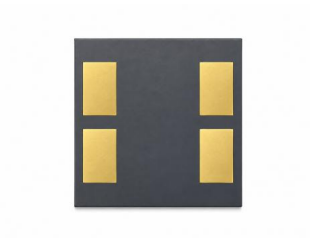
端口数量: 数值: 2

电阻值: 典型值: 15; 单位: Ω

阻值精度: 典型值: ±5; 单位: %

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCRES-N2-R20OHM

2 × 20 Ω GaAs薄膜电阻裸芯片

电阻值: 20 / 20 Ω (典型值); 线性工作电流: 0.165 / 0.165 A (典型值); 最大承受电流: 0.33 A (最大值). 裸片平面尺寸: 0.5 × 0.5 mm.

电阻数量: 数值: 2

端口数量: 数值: 4

电阻值: 典型值: 20 / 20; 单位: Ω

阻值精度: 典型值: ±5; 单位: %

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCRES-R50OHM

50 Ω GaAs薄膜电阻裸芯片

电阻值: 50 Ω (典型值); 线性工作电流: 0.2 A (典型值); 最大承受电流: 0.6 A (最大值). 裸片平面尺寸: 0.5 × 0.5 mm.

电阻数量: 数值: 1

端口数量: 数值: 2

电阻值: 典型值: 50; 单位: Ω

阻值精度: 典型值: ±5; 单位: %

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书



LCRES-R1000OHM

1000 Ω GaAs薄膜电阻裸芯片

电阻值: 1000 Ω (典型值); 线性工作电流: 0.04 A (典型值); 最大承受电流: 0.08 A (最大值). 裸片平面尺寸: 0.5 × 0.5 mm.

电阻数量: 数值: 1

端口数量: 数值: 2

电阻值: 典型值: 1000; 单位: Ω

阻值精度: 典型值: ±5; 单位: %

TA = +25 °C

产品详情　产品规格书

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。